

1x 250GB SAMSUNG 850 EVO SATA3 - 540 MB/S read 520 MB/S write MZ-75E250B

Qu'est ce que la V-NAND 3D et quelles sont ses différences avec les technologies existantes ?

L'architecture unique et innovantes de la mémoire flash V-NAND 3D de Samsung est une avancée technologique permettant de dépasser les limites de densité, les performances et l'endurance de l'architecture NAND plane traditionnelle. Fabriquée en empilant 32 couches de cellules verticalement au lieu de réduire la taille des cellules et de s'inscrire dans un espace horizontal fixe, la V-NAND 3D permet d'augmenter la densité ainsi que les performances tout en limitant son empreinte.



Optimisez votre expérience informatique au quotidien à l'aide de la technologie TurboWrite qui offre des vitesses de lecture / écriture sans précédent.

Grâce à la technologie TurboWrite de Samsung, vous obtenez des performances optimales en matière de lecture et d'écriture et par conséquent, vous maximisez votre utilisation informatique au quotidien. En plus d'une expérience utilisateur 10% supérieure à celle du 840 EVO*, vous obtenez également des vitesses d'écritures aléatoires jusqu'à 1.9 fois plus rapides. Ceci est aussi valable pour les modèles 120 / 250 Go**. Le 850 EVO offre les meilleures performances en ce qui concerne les vitesses de lecture (540 Mo/s) et d'écriture (520 Mo/s) séquentielles. De plus, vous obtenez des performances aléatoires optimisées pour toutes les profondeurs de file d'attente en cas d'utilisation d'un PC client. *PCMark7 (250 Go) : 6700 (840EVO) > 7600 (850EVO). **Ecriture aléatoire (profondeur de file d'attente : 32, 120 Go) : 36 000 IOPS (840EVO) > 88 000 IOPS (850EVO).

Passez à la vitesse supérieure avec le RAPID mode amélioré.

Accélérez vos performances à tout moment avec le logiciel Samsung Magician qui offre le RAPID mode pour un traitement des données 2 fois plus rapides* au niveau du système. Pour ce faire, celui-ci utilise la mémoire libre du PC (DRAM) comme stockage du cache. Tandis que l'utilisation de la mémoire maximale en RAPID mode était de 1 Go dans la version précédente du 840 EVO, le nouveau Magician la fait passer à 4 Go dans le 850 EVO grâce à l'application d'une mémoire dRAM de 16 Go. Vous doublez également vos performances* dans toutes les profondeurs de file d'attente aléatoires. *PCMark7 RAW (250 Go) : 7 500 >15 000 (RAPID mode).

Endurance et fiabilité, garanties renforcées par la technologie V-NAND 3D.

Avec deux fois plus de TBW* comparé à la génération précédente du 840 EVO**, le 850 EVO offre une endurance et une fiabilité garanties renforcées par une garantie de 5 ans, la plus élevée dans ce secteur. Le 850 EVO augmente ses performances continues jusqu'à 30% de plus que celles du 840 EVO grâce à une dégradation des performances réduite au minimum. Cela en fait l'un des appareils de stockage les plus fiables***. *TBW : Total Bytes Written. **TBW : 43 (840EVO) > 75 (850EVO 120 / 250 Go) , 150 (850EVO 500 Go / 1 To). ***PErformances soutenues (250 Go) : 3300 IOPS (840EVO) > 6500 IOPS (850EVO), performances mesurées après un test d'"Ecriture aléatoire" de 12 heures.

Utilisez votre ordinateur plus longtemps grâce à une faible consommation d'énergie renforcée par la V-NAND 3D.

Le 850 EVO augmente considérablement la durée de vie de la batterie de votre ordinateur portable grâce à un contrôleur optimisé pour la V-NAND 3D. Ce contrôleur active à présent la fonction Device Sleep pour une très faible consommation de 2 mW. Grâce au fait que la V-NAND 3D consomme deux fois moins d'énergie que la Planar NAND 2D, le 850 EVO consomme désormais 25% d'énergie en moins que le 840 EVO durant les opérations d'écriture*. *Puissance (250 Go) : 3.2 watts (840EVO) > 2.4 watts (850EVO).

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	25-06-2026
Prix individuel (HTVA, en euro):	49.5 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	59.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	59.9 €